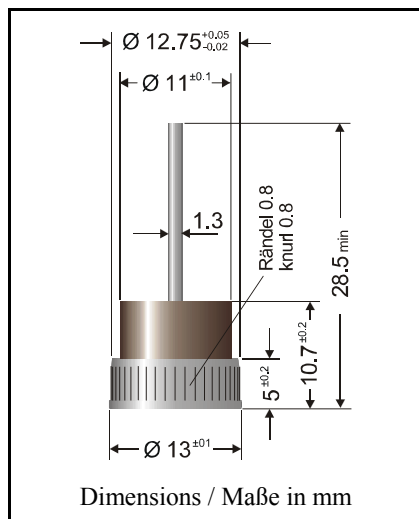


Silicon Press-Fit-Diodes
High-temperature diodes

Silizium-Einpreßdioden
Hochtemperaturdioden



Nominal current – Nennstrom 35 A

Repetitive peak reverse voltage 50...600 V
 Periodische Spitzensperrspannung

Metal press-fit case with plastic cover
 Metall-Einpreßgehäuse mit Plastik-Abdeckung

Weight approx. – Gewicht ca. 10 g

Casting compound has UL classification 94V-0
 Vergußmasse UL94V-0 klassifiziert

Standard packaging: bulk
 Standard Lieferform: lose im Karton

Maximum ratings

Grenzwerte

Type / Typ	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Wire to / Draht an	Periodische Spitzensperrspanng.	Stoßspitzensperrspannung
Anode Cathode	V_{RRM} [V]	V_{RSM} [V]
BYP 35A05	50	60
BYP 35A1	100	120
BYP 35A2	200	240
BYP 35A3	300	360
BYP 35A4	400	480
BYP 35A6	600	700

Max. average forward rectified current, R-load Dauergrenzstrom in Einwegschaltung mit R-Last	$T_C = 150^\circ\text{C}$	I_{FAV}	35 A
Repetitive peak forward current Periodischer Spitzenstrom	$f > 15\text{ Hz}$	I_{FRM}	110 A ¹⁾
Peak forward surge current, 50 / 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 50 / 60 Hz Sinus-Halbwellen	$T_A = 25^\circ\text{C}$	I_{FSM}	360 / 400 A
Rating for fusing – Grenzlasterintegral, $t < 10\text{ ms}$	$T_A = 25^\circ\text{C}$	i^2t	660 A ² s
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+215 °C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	– 50...+215 °C
Maximum pressure – Maximaler Einpreßdruck			7 kN

¹⁾ Max. case temperature $T_C = 150^\circ\text{C}$ – Max. Gehäusetemperatur $T_C = 150^\circ\text{C}$

Characteristics

Kennwerte

Forward voltage – Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 35\text{ A}$	V_F	$< 1.1\text{ V}$
Leakage current – Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 100\text{ }\mu\text{A}$
Thermal resistance junction to case Wärmewiderstand Sperrschicht – Gehäuse			R_{thC}	$< 0.8\text{ K/W}$

